MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
PUBLIC RELATIONS DIVISION
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8310 (Japón)

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA **N.º 3323**

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Consultas de los clientes

Semiconductor & Device Marketing Div. B
Mitsubishi Electric Corporation

www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/

Consultas de los medios

Public Relations Division
Mitsubishi Electric Corporation
prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
www.MitsubishiElectric.com/news/

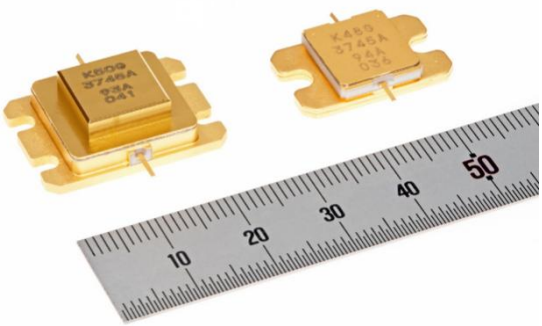
Mitsubishi Electric va a ampliar la línea de GaN-HEMT en la banda Ku

Los nuevos modelos serán compatibles con las comunicaciones multiportadora, el aumento de la capacidad de transmisión de datos y la reducción del tamaño de las estaciones terrestres de comunicaciones *por satélite*

TOKIO, 12 de diciembre de 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO, 6503) ha anunciado hoy que su línea de transistores de alta movilidad de electrones de nitruro de galio (GaN-HEMT), diseñados para su utilización en estaciones terrestres de comunicación por satélite (SATCOM), se ampliará con la adición de nuevos GaN-HEMT de 70 y 100 W en la banda Ku (entre 12 y 18 GHz), adecuados para aplicaciones multiportadora. El modelo de GaN-HEMT de 70 W consigue una baja distorsión de la intermodulación de tercer orden (IMD3)* con una amplia frecuencia de desvío** de hasta 400 MHz, que se considera el nivel más alto del sector. Por su parte, el modelo de GaN-HEMT de 100 W combina una potencia de salida incomparable con una IMD3 baja y una frecuencia de desvío de hasta 200 MHz. Mitsubishi Electric comenzará a enviar muestras de ambos modelos el 15 de enero.

* Medida del rendimiento de distorsión de un amplificador en el caso de señales de dos tonos

** Diferencia de frecuencia entre señales de dos tonos, utilizadas en las mediciones de IMD3



GaN-HEMT para estaciones terrestres de SATCOM en la banda Ku
Izquierda: MGFK50G3745A (100 W) Derecha: MGFK48G3745A (70 W）

La demanda de comunicaciones y de recepción de noticias por satélite (SNG) en la banda Ku está creciendo rápidamente, con el objetivo de garantizar las comunicaciones en el supuesto de que ocurran desastres naturales y para las zonas rurales en las que es difícil instalar equipos de red de cable. Además, las comunicaciones de alta velocidad, con una capacidad cada vez mayor, han supuesto una ampliación de las necesidades en materia de comunicaciones por satélite, tanto multiportadora como monoportadora. Se espera que los nuevos GaN-HEMT de Mitsubishi Electric aceleren la materialización de estaciones terrestres más pequeñas, así como de comunicaciones más rápidas y de mayor capacidad para distintas necesidades.

Programa de ventas

Producto	Aplicación	Modelo	Descripción general			Envío
			Frecuencia	Potencia de salida en estado de saturación	Frecuencia de desvío	
GaN-HEMT en la banda Ku	Estaciones terrestres de SATCOM	MGFK48G3745A	13,75-14,5 GHz	48,3 dBm (70 W)	Hasta 400 MHz	15 de enero de 2020
		MGFK50G3745A		50,0 dBm (100 W)	Hasta 200 MHz	

Características del producto

1) ***La frecuencia de desvío líder del sector, con una amplitud de hasta 400 MHz para comunicaciones por satélite de gran capacidad***
   - El modelo MGFK48G3745A utiliza un nuevo circuito coincidente para proporcionar una amplia frecuencia de desvío líder del sector, que es 80 veces mayor que la de los modelos actuales. Además, presenta IMD3 baja con una amplia frecuencia de desvío de hasta 400 MHz, para comunicaciones por satélite de gran capacidad y alta velocidad, incluso para comunicaciones multiportadora.
2) ***La potencia de salida inigualable de hasta 100 W contribuirá a la reducción de tamaño de las estaciones terrestres de SATCOM***
   - El modelo MGFK50G3745A utiliza circuitos coincidentes de transistores optimizados para proporcionar 100 W de potencia de salida de pico e IMD3 baja, a fin de ayudar a reducir el tamaño de las estaciones terrestres de SATCOM mediante la disminución de los componentes que incorporan.

Línea revisada y especificaciones principales (nuevos modelos en negrita).

Modelo	MGFG5H1503	MGFK48G3745	**MGFK48G3745A**	MGFK50G3745	**MGFK50G3745A**
Frecuencia	13,75 GHz-14,5 GHz				
Potencia de salida en estado de saturación	43 dBm (20 W)	48,3 dBm (70 W)	48,3 dBm (70 W)	50,0 dBm (100 W)	50,0 dBm (100 W)
Ganancia lineal	24dB	12dB	11dB	10dB	10dB
Frecuencia de desplazamiento @IMD3=-25 dBc	Máx. 5MHz	Máx. 5MHz	Máx. 400MHz	Máx. 5MHz	Máx. 200 MHz

Conciencia medioambiental

Estos productos cumplen con lo dispuesto en las directivas 2011/65/UE y (UE) 2015/863 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS, por sus siglas en inglés).

Nota: el desarrollo de estos productos ha contado con el apoyo parcial de la organización para el desarrollo de energías nuevas y tecnologías industriales (NEDO) de Japón.

###

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation

Con casi 100 años de experiencia en la provisión de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) es un líder mundial reconocido en la fabricación, comercialización y venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el procesamiento de la información y las comunicaciones, en el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrónicos de consumo, en la tecnología industrial, en la energía, en el transporte y en los equipos de construcción. Aprovechando el espíritu de su declaración corporativa "Changes for the Better" y su declaración medioambiental "Eco Changes", Mitsubishi Electric se esfuerza por ser una empresa internacional comprometida con el medio ambiente líder y por enriquecer la sociedad con la tecnología. La empresa registró unos ingresos por valor de 4 519 900 de yenes (unos 40 700 millones de dólares estadounidenses*) en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2019. Para obtener más información, visite:
www.MitsubishiElectric.com
*Tipo de cambio de 111 yenes por dólar estadounidense, fijado por el Mercado de divisas de Tokio el 31 de marzo de 2019.